







	<h2>SIR470DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR470DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR470DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 79510 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR470DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	79510 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5660pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR470DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR470DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR470DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR470DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR472ADP VISHAY VISHAY DFN56</p>	 <p>SIR472ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 18A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR470DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR470DP-T1-E3 QFN SIR470DP-T1-E3 QFN</p>
 <p>SIR468DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR470DP VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIR468DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR468DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

SIR470DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3
SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3
SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3
SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3	SIR470DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited